



特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

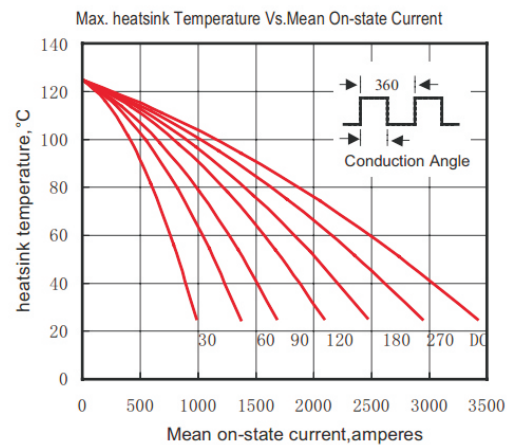
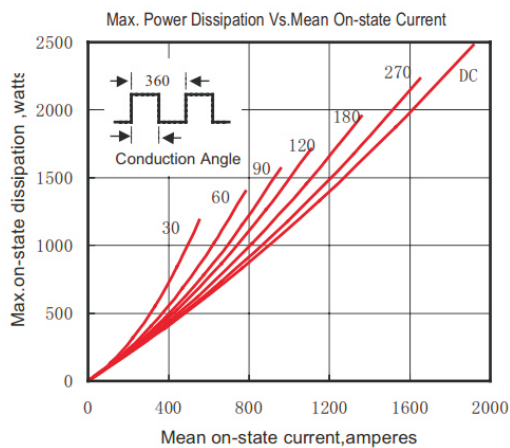
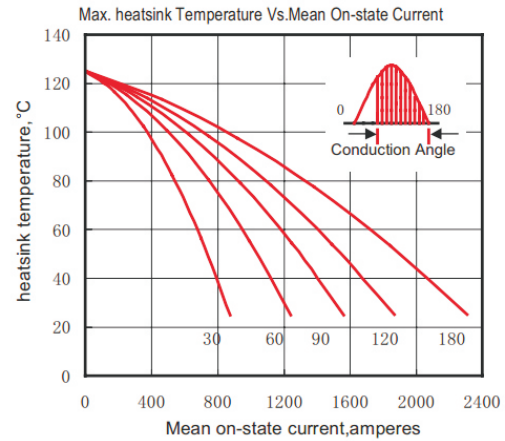
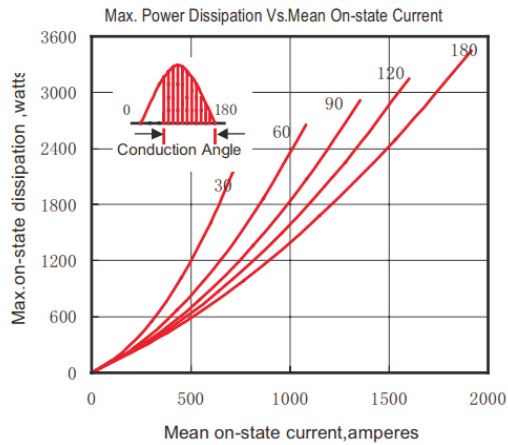
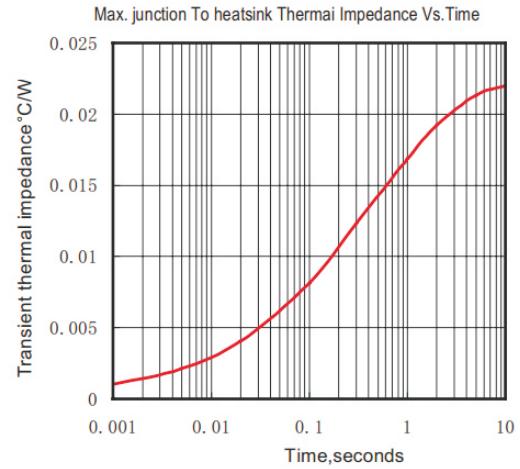
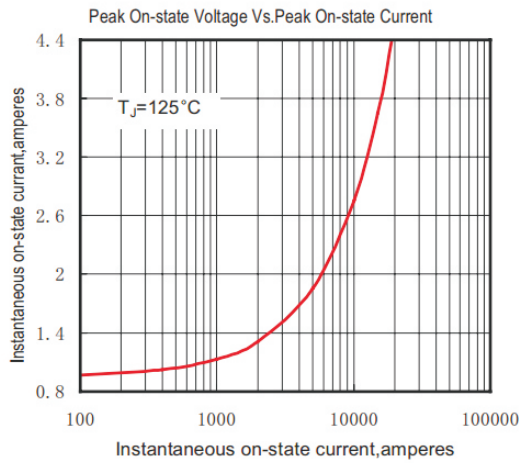
- | | | |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. 逆变器 | $I_{T(AV)}$ | 1600A |
| 2. 斩波器 | V_{DRM}/V_{RRM} | 1600V |
| | I_{TSM} | 26KA |
| 3. 感应加热 | I^2t | 3380 10 ³ A ² S |

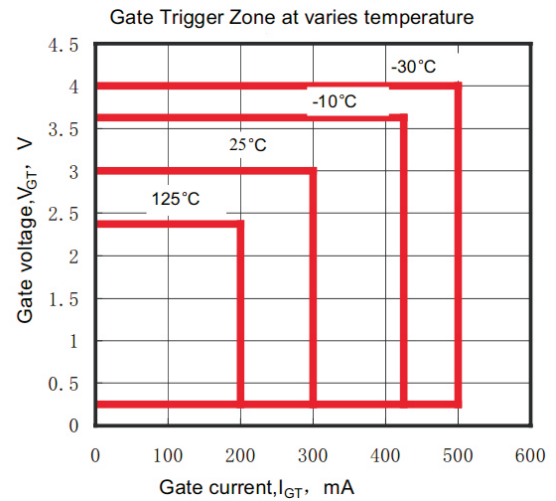
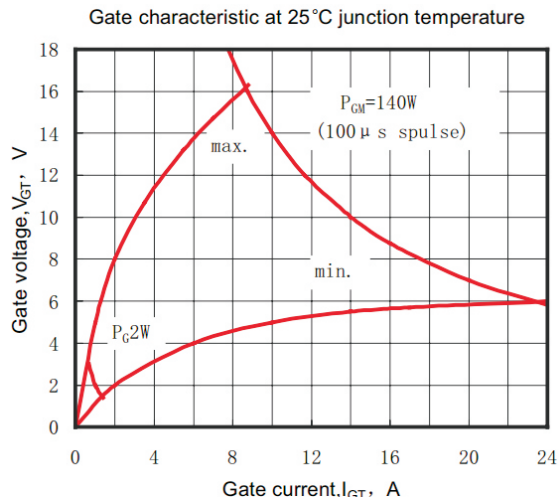


主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			T _J (°C)	最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, T _{hs} =106°C	125			1600	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM}$, t _p =10ms	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 100V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_D = V_{DRM}$	125			120	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R = V_{RRM}$	125			120	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽正弦半波	125			24	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6 V_{RRM}$	125			2880	A ² s*10 ³
V_{TO}	门槛电压		125			1.30	V
r_T	斜率电阻		125			0.35	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM} = 1500A$, F=15kN	125			2.35	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM} = 67\% V_{DRM}$	125			1000	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM} = 67\% V_{DRM}$ to 1000A 门极脉冲 tr ≤ 0.5μs I _{GM} = 1.5A 重复值	125			250	A/μs
I_{rm}	反向恢复电流	$I_{TM} = 500A$, t _p =1000μs,	125			250	A
trr	反向恢复时间	di/dt = -20A/μs,	125			24	μs
Qrr	恢复电荷	$V_R = 50V$	125			3000	μC
I_{GT}	门极触发电流	$V_A = 12V$, I _A =1A	25	35		300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A = 12V$, I _A =1A	25	0.8		3.0	V
I _H	维持电流	$V_A = 12V$, I _A =1A	25	20		250	mA
T _{stg}	存储温度	$V_A = 12V$, I _A =1A		-40		140	°C

性能曲线图





外形尺寸图

